

Conditions de dépôts, Spider 600

PM	Cibles	films	Recettes	RF Bias	Source	Puiss. [W]	Ar [sccm]	O ₂ [sccm]	N ₂ [sccm]	V [nm/mn]	Rampe [s]	Remarques	Durée [mn:ss]	Epais. [nm]
1	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Al2O3-#	-	RF	700	50.0	-	-	14.0	30	Durée de dépôt [mn] = Epaisseur [nm] / 16.38 [nm/mn] + 0.3 mn	07 : 27	100
1	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Al2O3_F-#	-	RF	700	50.0	2.0	-	2.5	30	Durée de dépôt [mn] = Epaisseur [nm] / 2.47 [nm/mn] - 2 mn	38 : 29	100
1	GeO ₂	GeO ₂	GeO2-#	-	RF	1 000	15.0	-	-		60			
1	GeO ₂	GeO ₂	GeO2_F-#	-	RF	1 000	15.0	2.0	-		60			
1	ITO	ITO	ITO-#	-	RF	500	15.0	-	-	86.4	30	Durée de dépôt (<25nm) [mn] = Epaisseur [nm] / 86.4 [nm/mn] + 0 mn. 0.4mΩ.cm	00 : 17	25
1	ITO	ITO	ITO-#	-	RF	500	15.0	-	-	176.0	30	Durée de dépôt (>100nm) [mn] = Epaisseur [nm] / 176 [nm/mn] + 1 mn. 0.4mΩ.cm	01 : 34	100
1	ITO	ITO	ITO_F-#	-	RF	500	15.0	2.0	-	22.1	30	Durée de dépôt [mn] = Epaisseur [nm] / 22.1 [nm/mn] + 1 mn. 25mΩ.cm	05 : 31	100
1	MgO	MgO	MgO-#	-	RF	1 000	15.0	-	-	9.0	60	Durée de dépôt [mn] = Epaisseur [nm] / 9.0 [nm/mn] + 0.15 mn	12 : 07	100
1	MgO	MgO	MgO_F-#	-	RF	1 000	15.0	2.0	-	8.6	60	Durée de dépôt [mn] = Epaisseur [nm] / 8.6 [nm/mn] + 0.9 mn	12 : 38	100
1	SiO ₂	SiO ₂	SiO2-#	-	RF	1 000	15.0	-	-	58.0	30		01 : 58	100
1	SiO ₂	SiO ₂	SiO2_F-#	-	RF	1 000	98.0	13.0	-	11.9	30	Throttle Valve Open	08 : 39	100
1	Ta ₂ O ₅	Ta ₂ O ₅	TaOx-#	-	RF	1 000	15.0	-	-	117.5	60		01 : 21	100
1	Ta ₂ O ₅	Ta ₂ O ₅	TaOx_F-#	-	RF	1 000	15.0	3.0	-	13.4	60		07 : 58	100
1	Ti_r	Ti	Ti(1)-#	-	RF	1 000	15.0	-	-	90.0	4		01 : 09	100
1	Ti_r	TiO ₂	TiO2(1)-#	-	RF	1 000	11.0	4.0	-	34.0	4		02 : 58	100
1	Ti_r	TiN	TiN(1)-#	-	RF	1 000	40.0	-	15.0	14.2	4	Throttle Valve Open	07 : 05	100
1	TiO ₂	TiO ₂	TiO2_T-#	-	RF	500	15.0	-	-	13.4	30		07 : 44	100
1	TiO ₂	TiO ₂	TiO2_T_F-#	-	RF	500	15.0	1.0	-	2.0	30		49 : 31	100
1	V ₂ O ₅	V ₂ O ₅	V2O5-#	-	RF	500	15.0	-	-	7.3	30		13 : 57	100
1	V ₂ O ₅	V ₂ O ₅	V2O5_F-#	-	RF	500	15.0	2.0	-	1.6	30		62 : 45	100
2	Al	AlN	AlN_T-#	5	DC Pinnacle	1 500		-	50.0	50.0	10	Throttle Valve Open	02 : 05	100
3	Mo	Mo	Mo-#	-	DC Maris	2 000	5.0	-	-	411.5	5		00 : 17	100
3	Pt	Pt	Pt-#	-	DC Maris	1 000	15.0	-	-	270.0	5		00 : 47	200
3	Pt	Pt	Pt_200W-#	-	DC Maris	200	15.0	-	-	?	2			
3	Ru	Ru	Ru-#	-	DC Maris	1 000	15.0	-	-	230.0	5		00 : 29	100
3	Si	Si	Si-#	-	DC Maris	800	29.0	-	-	105.0	20	Stress 25 Mpa (tension), unif. 5.55% (49 pts)	01 : 07	100
3	W	W	W-#	-	DC Maris	1 000	56.0	-	-	185.0	5		00 : 35	100
3	WTi 10%	WTi 10%	WTi-#	-	DC Maris	1 000	56.0	-	-	178.0	5		00 : 36	100
4	Al (et AlSi)	Al (et AlSi)	Al-#	-	DC Maris	2 000	15.0	-	-	480.0	5	7.06.10 ⁻² Ω/□	00 : 15	100
4	Al (et AlSi)	Al (et AlSi)	Al_200W-#	-	DC Maris	200	15.0	-	-	34.0	2		02 : 57	100
4	Al (et AlSi)	Al (et AlSi)	Al_400W-#	-	DC Maris	400	15.0	-	-	75.0	2		01 : 21	100
4	Ta	Ta	Ta-#	-	DC Maris	1 000	15.0	-	-	150.0	5		00 : 43	100
4	Ti	Ti	Ti-#	-	DC Maris	1 000	9.0	-	-	120.0	5		00 : 13	20

Conditions de dépôts, Spider 600

Xx_T-# Dépôt en température

Xx_E-# Dépôt avec RF Etch de la plaque

Xx_F-# Dépôt avec flux de gaz

Xx_D-# Dépôt développement